

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-054673
 (43)Date of publication of application : 26.02.1999

(51)Int.Cl.

H01L 23/36

(21)Application number : 09-205561

(71)Applicant : NEC KANSAI LTD

(22)Date of filing : 31.07.1997

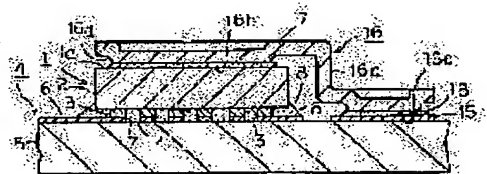
(72)Inventor : HINO JIICHI

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a semiconductor device of flip chip structure which is thin, small-sized and capable of large power operation, by connecting a rear electrode through which a main current of a power transistor pellet flows with a wiring board, by using a thermoelectric connection member of low resistance which is free from self heat generation and excellent in thermal conduction.

SOLUTION: Bump electrodes 3 and a rear electrode 1a are formed on both surfaces of a semiconductor pellet 1. Fine pad electrodes 7 and a large diameter pad electrode 15 to which a main current is supplied are formed on a wiring board 4. In this device, the bump electrodes 3 and the fine pad electrodes 7 are overlapped and made to face each other. Overlapping parts of the respective electrodes are electrically connected. The rear electrode 1a and the large diameter pad electrode 15 are connected with a thermoelectric connection member 16 having thermally and electrically excellent conductivity, via adhesive materials 17, 18 having thermally and electrically excellent conductivity.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 07.12.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 18.08.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(11)特許出願公開番号

特開平11-54673

(43)公開日 平成11年(1999)2月26日

D

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 5 頁)

(71)出願人 000156950

関西日本電気株式会社

滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号

(72) 發明者 樋野 滋一

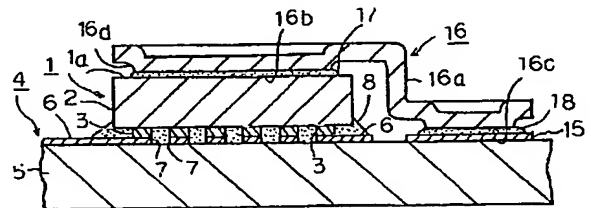
滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日
本電気株式会社内

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57) 【要約】

【課題】従来のフリップチップ構造の半導体装置では熱的、電気的に大電力動作させることが困難であった。

【解決手段】バンパ電極３と裏面電極１aとを両面に形成した半導体ベレット１と、微小パッド電極７と主電流が供給される径大パッド電極１５とを形成した配線基板４とを、バンパ電極３と微小パッド電極７とを重畳させて対向させ各電極の重合部を電気的に接続するとともに、背面電極１aと径大パッド電極１５間を、熱的、電気的に良好な伝導性を有する接着材１７、１８を介して熱的、電気的に良好な伝導性を有する熱電気接続部材１６に接続したことを特徴とする半導体装置。



【特許請求の範囲】

【請求項1】一主面にバンパ電極を形成し他の主面に裏面電極を形成した半導体ペレットと、半導体ペレットのバンパ電極に対応する位置に微小パッド電極を形成するとともに微小パッド電極形成領域の外方に主電流が供給される径大パッド電極を形成した配線基板とを、バンパ電極と微小パッド電極とを重合させて対向させ各電極の重合部を電氣的に接続するとともに、半導体ペレットの他の主面と径大パッド電極間を、熱的、電氣的に良好な伝導性を有する接着材を介して熱的、電氣的に良好な伝導性を有する熱電気接続部材に接続したことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】熱電気接続部材の半導体ペレットと接続される部分に接着材の厚みを規制する突起を設けたことを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】熱電気接続部材の半導体ペレットと接続される部分に余剰の接着材を逃がす穴または溝を形成したことを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項4】肉薄部と肉厚部とを隣接させた金属板にて熱電気接続部材を構成し、肉薄部を半導体ペレットの他の主面と、肉厚部を配線基板の径大パッド電極とそれぞれ対向させ、接着材を介して電氣的に接続したことを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項5】熱電気接続部材の外面に凹凸を形成したことを特徴とする請求項4に記載の半導体装置。

【請求項6】熱電気接続部材が銅またはアルミニウムからなり、接着材と接触する部分が接着材に対して濡れ性の良好な面に形成されたことを特徴する請求項1に記載の半導体装置。

【請求項7】熱電気接続部材の接着材との接触部を除く部分が絶縁被覆されたことを特徴する請求項1に記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はフリップチップ構造の半導体装置に関し、特に大電流動作する半導体ペレットを具えた半導体装置に関する。

【0002】

【従来の技術】電子回路装置は、配線基板に小型の電子部品を高密度実装し、装置の小型化と高機能、高性能化を実現している。この小型の電子部品の一例を図6から説明する。図において、1は半導体ペレットで、内部に多数の半導体素子（図示せず）を形成した半導体基板2の一主面に多数のバンパ電極3を形成している。4は配線基板で、樹脂やセラミクスなどの絶縁部材よりなる絶縁基板5に導電パターン6を形成し、この導電パターン6の一部で半導体ペレット1のバンパ電極3と対向する部分にパッド電極7を形成している。この半導体ペレット1と配線基板4とはバンパ電極3とパッド電極7とが重合するように対向配置され、各電極3、7は熱圧着や

溶融接続により電氣的に接続される。8は半導体ペレット1と配線基板4とを機械的に接続し半導体ペレット1表面の配線パターン（図示せず）を外部の腐食性ガスから保護する接着用樹脂を示す。この種半導体装置は、半導体ペレット1として高密度集積されたものを用いることにより、小型で薄い電子部品を実現できる。またこの種半導体装置は、半導体ペレット1としてマイクロプロセッサを用い、配線基板4の図外領域に、メモリや入出力インターフェースなどの周辺電子部品をマウントすることにより、配線基板4の単位で電子回路装置を構成することもできる。ところで、半導体ペレット1は小信号用のものでは、図示例のように一主面にバンパ電極3を集中させることができる。一方、大電流を取り扱う半導体ペレットでは、微小なバンパ電極に大電流が集中すると電極部分や電極の重合部を損傷するため、複数のバンパ電極を並列接続して電流を分散させ電流容量を増大させている。また、電力用のトランジスタやFETなどを含み、両面に主電流が流れる電極を形成した半導体ペレットでは、バンパ電極側の主電流電極とともに他の面（裏面）の主電流電極を、それぞれ配線基板の導電パターンに接続する必要がある。そのため裏面電極と配線基板とをワイヤボンディングすることが考えられるが、ワイヤによる接続はワイヤの立ち上がり部分の高さ分だけ半導体装置の厚さが厚くなり、小型化、薄型化の目的に反する。このような問題を解決するものとして、特表平7-503579号公報には図7に示すように、半導体ペレット1にスパッタ金属フィルム9を、その導電面の中央部を半導体ペレット1の裏面電極1aに当接させ、周縁部を配線基板4上の導電パターン10に当接させて、それぞれの当接面を電氣的に接続した構造の半導体装置が開示されている。また、米国特許第5、586、010号明細書には、図8に示すように矩形穴11aを有する絶縁基板11の一方の面に導電層12を形成し、この導電層12を矩形穴11a部分で中央部が平坦なドーム状に成形して、このドーム状成形部12aに肉厚の支持部材13を固定し、さらにこの支持部材13に半導体ペレット14を固定した構造の半導体装置が開示されている。上記図7半導体装置は半導体ペレット1の裏面電極1aを配線基板4に電氣的に接続し、図8半導体装置はバンパ電極を有する半導体ペレットではないが、半導体ペレット14が発生する熱を支持部材13と導電層12に伝達し、さらに導電層12から絶縁基板11に伝達して、半導体ペレット14を冷却するものである。これらはいずれも、半導体ペレット1、14の裏面電極を配線基板4、11に接続することができ、薄型の半導体装置に好適である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図7、図8に示す半導体装置はいずれも、熱および電流の通過断面積が極めて小さい導電膜によって半導体ペレットの

裏面電極と配線基板との間の接続が行われるため、熱伝導率が小さく、放熱性が実質的に支持部材13で決定され、導電膜の許容電流で半導体装置の動作電流が制限されるという問題があった。即ち、半導体ベレットは動作開始すると室温状態から温度上昇し、この半導体ベレットと熱的に密着した導電膜の電気抵抗も温度上昇とともに増大する。導電膜材料が例えば銅の場合、その電気抵抗は20℃で $1.72\Omega\cdot\text{m}$ であるのに対し、100℃では $2.28\Omega\cdot\text{m}$ となり33%増大し、自己発熱量も増大して周囲温度より高くなり半導体ベレットからの熱の流入を阻止し、熱的、電氣的抵抗が増大するため半導体ベレットからの電流が低下し出力が低下する。そのため、図7、図8に示す構造の半導体は大電流で連続的に動作するモータなどの駆動制御用半導体装置には適用しにくく、適用するとしてもブローなどの冷却手段が必要で装置全体の小型化は困難であった。

【0004】

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題の解決を目的として提案されたもので、一方の面にバンプ電極を他の面に裏面電極をそれぞれ形成した半導体ベレットを、微小パッド電極と径大パッド電極とをそれぞれ形成した配線基板に、バンプ電極と微小パッド電極とを重合させて対向させ各電極の重合部を電氣的に接続するとともに、半導体ベレットの他の面に形成した裏面電極と径大パッド電極間を、熱的、電氣的に良好な伝導性を有する接着材を介して熱的、電氣的に良好な伝導性を有する熱電気接続部材に接続したことを特徴とする半導体装置を提供する。

【0005】

【発明の実施の形態】本発明による半導体装置は、半導体ベレットの裏面電極と径大パッド電極間を、熱的、電氣的に良好な伝導性を有する接着材を介して熱的、電氣的に良好な伝導性を有する熱電気接続部材に接続したことを特徴とするが、熱電気接続部材の半導体ベレットと接続される部分に接着材の厚みを規制する第1の突起を設けることにより、半導体ベレットのオンオフ動作の繰り返しによる温度上昇、低下その結果としての熱膨張、収縮による半導体ベレットと接着材間に生じる応力を緩和させることができる。また、熱電気接続部材の半導体ベレットと接続される部分に余剰の接着材を逃がす穴または溝を形成することもできる。これにより余剰の接着材が半導体ベレットの側壁など不所望部分に広がり付着するのを防止でき、接着材の厚みのばらつきを抑えることができる。また肉薄部と肉厚部とを隣接させた金属板にて熱電気接続部材を構成し、肉薄部を半導体ベレットの他の主面と、肉厚部を配線基板の径大パッド電極とそれぞれ対向させ、接着材を介して電氣的に接続することにより、放熱性が良好で組立性の良い半導体装置を実現できる。この場合、熱電気接続部材の外面に凹凸を形成し、表面積を増大させ放熱効果を向上させることができ

る。熱電気接続部材は熱的、電氣的に良好な伝導性を有する材料を用いられるが、具体的には加工性も良好な銅またはアルミニウムが好適で、接着材と接触する部分は接着材に対して濡れ性の良好な面に形成される。熱電気接続部材が半導体ベレットの充電部に接続される場合には、熱電気接続部材の接着材との接触部を除く部分を予め絶縁被覆しておくことが好ましい。

【0006】

【実施例】以下に本発明の実施例を図1から説明する。図において、図6と同一物には同一符号を付して重複する説明を省略する。本発明による半導体装置が図6半導体装置と相違する点を説明する。即ち、半導体ベレット1は一方の面にバンプ電極3が形成され、他の面には主電流が流れる裏面電極1aが形成されている。配線基板4は、絶縁基板5上の半導体ベレット1に形成されたバンプ電極3と対向する位置にバンプ電極3とほぼ同じ大きさの径小パッド電極7が形成され、このパッド電極3の形成領域の外方にパッド電極7に比して十分大きな径大パッド電極15を形成している。16は熱的、電氣的に良好な伝導性を有する銅などの金属平板をその両端部が平行となるように中間部を折り曲げて段差を設けた熱電気接続部材で、段差部分16aで隣り合う平面部16b、16cを半導体ベレット1の裏面電極1a、径大パッド電極15にそれぞれ対向させている。段差部16aは、半導体ベレット1の厚さ、バンプ電極3及びパッド電極7、15の高さ、接着材17、18の厚みなどが考慮され設定される。17、18はそれぞれ熱的、電氣的に良好な伝導性を有する半田や導電ペーストなどの接着材で、熱電気接続部材16を半導体ベレット1の裏面電極1a、径大パッド電極15にそれぞれ接続する。この半導体装置は、複数のパッド電極が裏面電極1aに対応して主電流が供給され、半導体ベレット1の大電流動作を可能にしている。熱電気接続部材16は半導体ベレット1の厚さの1/3以上あればよく、例えば厚さ100 μm とし、巾を半導体ベレット1の一辺の長さとはほぼ同じ巾、例えば15mmとすることにより、図7、図8に示す装置で導電膜の厚さが最大でも30 μm 程度しかできないことに比較して、熱的、電氣的通過断面積を格段に大きくできる。図1実施例では、熱電気接続部材16の接着部分をエンボス加工し30 μm 程度突出させ、この突出部16dの一辺の長さを半導体ベレット1の一辺の長さの90%程度に設定している。これにより、突出部16dからはみ出した余剰の接着材17は突出部16dの周縁に留まり、半導体ベレット1からはみ出さず、配線基板4上への流出が防止できる。また、図1実施例では、熱電気接続部材16の突出部16dを半導体ベレット1の裏面電極1aとほぼ同じ面積に設定したが、図2に示すように、半導体ベレット1の面積に比して十分小さい微小突起16eを形成することもできる。この微小突起16eは直径1mm程度で高さ50～100 μm

程度に設定され、その下端は接着材17を突き抜けて半導体ベレットの裏面電極1aに当接している。半導体ベレット1はオンオフ動作を繰り返すことによって、温度上昇、温度低下するが、微小突起16eにより接着材17の厚さを上記範囲に規制することにより半導体ベレット1、接着材17、熱電気接続部材16のそれぞれ熱膨張率の異なる接合界面にかかる応力を緩和し接合界面にクラックが発生するのを抑制し長時間動作の可能な半導体装置を実現できる。図3は本発明の他の実施例を示す。この実施例では熱電気接続部材16に接着材17の余剰分を逃がす穴16fを貫通している。これにより、接着材17の内、塗付領域中央の接着材を逃がし穴16f内に収容し、接着材17のはみ出しを効果的に防止できる。この逃がし穴16fは貫通穴だけでなく、両端が側壁に開口した溝でもよい。図4は本発明の他の実施例を示す。図1乃至図3実施例は金属平板を屈曲して熱電気接続部材16を形成したが、この実施例では、肉厚の金属平板の中間部乃至一側方に切削、ロール加工、プレス加工などの手段により肉薄部19aを形成し、この肉薄部19aに上面が面一となるように肉厚部19bを隣接させた熱電気接続部材19を用いている。この実施例では、半導体ベレット1で発生した熱は、肉薄部19aから半導体ベレット1と隣接する部分で肉厚部19bに伝達されるため、図1実施例に比較しても段差部16aの長さ分、実質的に熱伝達経路を短縮でき、しかも肉厚部19bは断面積が広いので、熱抵抗、電気抵抗ともに小さくでき、フリップチップ構造で大電力動作が可能な半導体装置を実現できる。この実施例に図2、図3にて説明した微小突起(16e)、逃がし穴(16f)を適用することによりそれぞれの有する効果を奏することができる。また図5に示すように熱電気接続部材19の上面に多数の溝19cを形成し、表面積を増大させて放熱性を向上させることもできる。上記それぞれの実施例において、熱電気接続部材16、19の具体的材料として銅を示したが、電気抵抗はやや高くなるものの軽量で加工性の良好なアルミニウムを用いることもできる。この場合、接着材17、18が接続される部分に、蒸着や溶射メッキなどの手段により銅や金、銀、半田、銀ロウなど接着性の良好な金属や合金の層を形成すればよい。また、熱電気接続部材16、19が高電位部分に接続されて用いられ、触れると感電の虞がある場合には、この熱電気接続部材16、19の外表面を絶縁被覆することでも

きる。この場合、静電塗装法などの手段により熱電気接続部材16、19の全面に樹脂層を形成し、接着材17、18が接続される部分にサンドブラストや切削により樹脂層に窓明けして熱電気接続部材の素地を露出させればよい。またこの窓明け部分に蒸着、溶射メッキなどにより熱的、電氣的に接着性の良好な層を形成しても良い。また図1乃至図4の実施例では、熱電気接続部材16、19を半導体ベレット1の裏面からその一側方に延在させた構造を示したが、半導体ベレット1に跨って周縁を半導体ベレット1を囲む位置に延在させてもよい。

【0007】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、電力用半導体ベレットの主電流が流れる裏面電極と配線基板とを低抵抗で自己発熱がなく、熱伝導性の良好な熱電気接続部材にて接続したから、薄く小型で大電力動作可能なフリップチップ構造の半導体装置を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による半導体装置の実施例を示す側断面図

【図2】 図1実施例の変形例を示す要部側断面図

【図3】 図1実施例の他の変形例を示す要部側断面図

【図4】 本発明による半導体装置の他の実施例を示す側断面図

【図5】 図4実施例の変形例を示す側断面図

【図6】 フリップチップ構造の半導体装置を示す側断面図

【図7】 裏面電極と配線基板とを電氣的に接続した半導体装置を示す側断面図

【図8】 半導体ベレットの放熱性を改善した半導体装置を示す側断面図

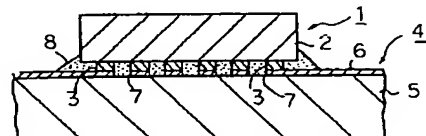
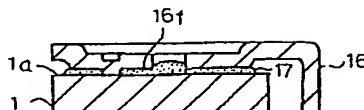
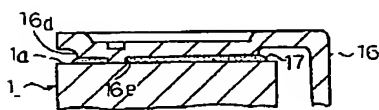
【符号の説明】

- 1 半導体ベレット
- 1a 裏面電極
- 3 バンプ電極
- 4 配線基板
- 7 微小パッド電極
- 15 径大パッド電極
- 16 熱電気接続部材
- 17 接着材
- 18 接着材
- 19 熱電気接続部材

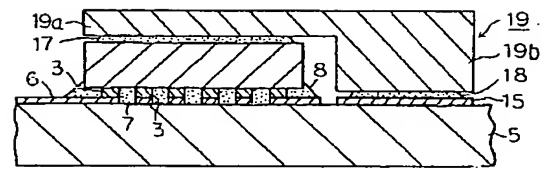
【図2】

【図3】

【図6】



【図4】



【図7】

